

半 导 体 学 报

第 13 卷 第 9 期 1992 年 9 月

目 录

- n 型砷化镓外延层中 1.48eV 发射带的时间分辨光谱的研究 段家祗 (523)
- 不连续类氧化层界面多晶硅发射极晶管理论模型.....
.....魏希文 李建军 马平西 邹赫麟 王阳元 张利春 吉利久 (528)
- 半导体激光器功率输出特性的理论分析及实验研究.....
.....刘德明 黄德修 黄菊仙 (539)
- 薄全耗尽 SOI 膜 N 沟道 MOSFET 强反型电流模型.....程玉华 王阳元 (547)
- CMOS 倒相链瞬态对延迟模型分析.....郝 跃 (554)
- 亚微米 MOS 场效应管的完全解析二维模型.....汤庭鳌 C. A. Paz de Araujo (564)
- 红外透射光谱测量重掺杂化合物半导体载流子浓度方法的研究.....
.....何秀坤 王 琴 李光平 阎 萍 汝琼娜 李晓波 (573)
- 研究简报**
- 霍尔器件的一种新的工作模式.....易明铈 (579)
- 研究快报**
- $Ga_{1-x}In_xSb/GaSb$ 应变层超晶格的 MOVPE 生长
.....陆大成 汪 度 刘祥林 万寿科 王玉田 (584)